

	<p><b>SIR808DP-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIR808DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR808DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22442 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22442 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	29.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	815pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIR808DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR808DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR808DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR808DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR808DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p>	 <p><b>SIR804DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR812DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR804DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SIR804DP-T1-GE2</b> VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p><b>SIR814DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR818DP</b> VISHAY SIR818DP VISHAY</p>	 <p><b>SIR814DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

### SIR808DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SIR808DP-T1-GE3</a>
<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIR808DP-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited